

TAGUNGSPROGRAMM

Mittwoch, 31. März 1993 17.00 – 17.15 Uhr
Begrüßung

Mittwoch, 31. März 1993 17.15 – 20.15 Uhr
Sub- μ m-Lithographie und Quantenstrukturen

- 17.15 – 17.45 W. Hausherr:
Konzept eines Rotationsaligners
- 17.45 – 18.15 P. Hudek, V. Barák, I. Kostic, M. Kovác:
Hochauflösende schreibende Elektronenstrahl-Lithographie und Electron-Beam-Testing
- 18.15 – 18.45 E. Cekan, W. Fallmann, G. Stangl:
Statusbericht über die Arbeiten mit dem Alpha-Ionenprojektor
- 18.45 – 19.15 W. Friza:
Strukturierung im Sub-0.5 μ m-Bereich durch Ablation mittels hochenergetischer Photonen und Ablationsentwicklung von ionenbelichteten organischen Resistmaterialien
- 19.15 – 19.45 F. Thalinger:
Herstellung von Quanteneffekt-Bauelementen mittels projizierender Ionenlithographie
- 19.45 – 20.15 M. Hauser:
Elektronenstrahlolithographie von Quantumwires und Antidots

Donnerstag, 1. April 1993 9.00 – 11.00 Uhr
Nanometer-Elektronik und Optoelektronik

- 9.00 – 10.00 E. Gornik:
Future Nanometer Electronics
- 10.00 – 10.30 T. Brabec, P.F. Curley, F. Krausz, Ch. Spielmann, E. Wintner:
Femtosekunden-Festkörperlaser
- 10.30 – 11.00 W. Jantsch, G. Hendorfer und L. Palmetshofer:
Erbium-dotiertes Silicium — Ausgangsmaterial für IR-Lichtquellen?

Donnerstag, 1. April 1993 17.00 – 18.30 Uhr
Postersitzung

Donnerstag, 1. April 1993 18.30 – 20.00 Uhr
Techniker-Diskussion

Freitag, 2. April 1993 **9.00 – 11.00 Uhr**
Micromachining und Sensoren

- 9.00 – 10.00 V.P. Jaecklin:
Surface Micromachining — a Versatile Technology for Microactuators
- 10.00 – 10.30 F. Kohl, A. Jachimowicz, R. Glatz, J. Steurer, D. Biacovsky, J. Kuttner,
G. Urban:
Miniaturisierte thermische Durchflußsensoren für Gase und Flüssigkeiten
- 10.30 – 11.00 G. Urban, G. Jobst, E. Aschauer, A. Jachimowicz, F. Kohl, R. Fasching,
T. Oubda, P. Svasek, E. Svasek, F. Keplinger:
Integrierte miniaturisierte Biosensoren

Freitag, 2. April 1993 **17.00 – 19.00 Uhr**
Kristalle und Meßtechnik

- 17.00 – 17.30 H. Sitter, W. Faschinger, P. Juza, F. Hauzenberger, K. Lischka, A. Pesek, H.
Zajicek:
*Atomlagenepitaxie zur Herstellung von Supergittern und Quantentopfstruk-
turen*
- 17.30 – 18.00 E. Koppensteiner, P. Hamberger, G. Bauer, H. Kibbel, H. Presting, E. Kas-
per, A. Pesek
Hochauflösende Röntgenbeugung an Si/SiGe Heterostrukturen
- 18.00 – 18.30 L. Palmeshofer, J. Reisinger, T. Schmidt:
Untersuchung von Defekten in Si und GaAs nach Ionenbestrahlung
- 18.30 – 19.00 K. Riedling:
Spektroskopische und in situ-Ellipsometrie: Stand der Technik

Samstag, 3. April 1993 **9.00 – 10.30 Uhr**
Design und Anwendungen

- 9.00 – 9.30 N. Kerö, G. Cadek, T. Sauter:
UNICHIP - ASIC Design mit österreichischen Universitäten
- 9.30 – 10.00 H. Leopold, R. Röhner, P. Söser:
*Monolithischer Quantisierer und Kodierer für als Periode und Tastverhält-
nis dargestellte analoge Größen*
- 10.00 – 10.30 K. Riedling, W. Ripl, W. Fallmann, B. Luger, P. Svasek, W. Winkler:
Langzeit-Meßsystem für Umweltparameter

Samstag, 3. April 1993 **10.30 – 11.00 Uhr**
Zusammenfassung und Verabschiedung

Posterbeiträge

R. Bischof, I. Maran, W. Seidenbusch:

InSb-Detektoren unter uniaxialem und hydrostatischem Druck

A. Bruckner:

Einsatz eines Feldemissions-Rasterelektronenmikroskops zur Beurteilung von Resiststrukturen im Nanometer-Bereich

G. Brunthaler, G. Bauer:

Strukturierung von II-VI Verbindungen: Anwendungen für optisch gepumpte ZnSe-Quantum-Well-Laser

R. Chabicovsky, J. Nicolics:

Laserlöten von Dünnschichtsensoren

C. G. Diskus, K. Lübke, A. L. Springer, H. W. Lettenmayr, H. W. Thim:

Monolithisch integrierter Millimeterwellenoszillator

N. Frank, G. Springholz, G. Bauer:

UHV-STM-Untersuchungen zum Wachstum von Verbindungshalbleitern

H.W. Lettenmayr, C.G. Diskus, K. Lübke, L. Palmetshofer, H.W. Thim:

Realisation of threshold voltage adjustable GaAs-MISFETS for VLSI

G. Stangl, E. Cekan, Ch. Eckes, W. Friza, F. Thalinger, A. Bruckner, P. Hudek, W. Fallmann:

Newly Developed Novolak-Based Resist Materials for Ion Projection Lithography (IPL) with Structure Dimensions of 200-100 Nanometers

E. Wirthl, H. Sitter, P. Bauer:

Auger-Elektronenspektroskopie zur Charakterisierung von Epitaxieschichten